廃止文書

文書名: 宇宙開発用信頼性保証 p チャネルパワーMOSFET

JAXA R

2SJ1A01, 2SJ1A02, 2SJ1A03, 2SJ1A04, 2SJ1A05, 2SJ1A06, 2SJ1A07, 2SJ1A08, 2SJ1A09, 2SJ1A10, 2SJ1A11, 2SJ1A12

個別仕様書

文書番号: JAXA-QTS-2030/104A

廃止日: 2022/7/29

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

登録番号

認仕-1229

宇 宙 開 発 用 信 頼 性 保 証 p チャネルパワーMOSFET

JAXA R 2SJ1A01, 2SJ1A02, 2SJ1A03 2SJ1A04, 2SJ1A05, 2SJ1A06 2SJ1A07, 2SJ1A08, 2SJ1A09 2SJ1A10, 2SJ1A11, 2SJ1A12

個別仕様書

作成•制定 : 富士電機株式会社

発行: 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構

改訂履歴表

版数	年月日	改訂内容
	2011-6-21	初版

目次

1	総 則1
	1.1 部品番号 1
	1.2 絶対最大定格2
	1.3 主要電気的特性 3
	1.4 耐放射線性 6
2	適用文書
3	要求事項
	3.1 設計及び構造7
	3.1.1 ケース及び電極接続7
	3.1.2 電極材料及び仕上げ7
	3.1.3 電気的特性7
	3.2 表示7
	3.2.1 検査ロット識別記号及び一連番号の表示7
	3.3 認定8
4	品質保証条項8
	4.1 一般的事項8
	4.2 受入材料の管理8
	4.3 製造工程の管理8
	4.4 工程内検査9
	4.5 スクリーニング・・・・・・9
	4.5.1 測定すべき電気的特性9
	4.5.2 試験条件 ·······10
	4.5.3 デルタ限界値10
	4.6 認定試験及び品質確認試験10
	4.6.1 静電気破壊試験条件 ·······11
	4.6.2 耐放射線性試験条件 ·······11
	4.7 試験及び検査の変更11
	4.8 長期間保管した製品の出荷11
5	引渡の準備
6	注意事項11
	6.1 用語の定義
	6.2 調達者に対する注意事項
	6.2.1 取り扱い上の注意事項11

JAXA-QTS-2	030/104A
令和2年3月	18 日制定

S.2.2 ベリリアについての注意事項······12

宇宙開発用信頼性保証 p チャネルパワーMOSFET

JAXA R

2SJ1A01, 2SJ1A02, 2SJ1A03 2SJ1A04, 2SJ1A05, 2SJ1A06 2SJ1A07, 2SJ1A08, 2SJ1A09 2SJ1A10, 2SJ1A11, 2SJ1A12

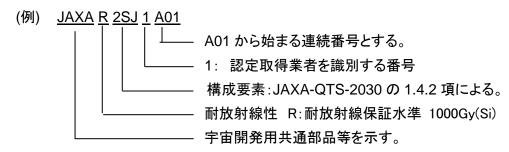
個別仕様書

1. 総則

この仕様書は、宇宙機に搭載する電子機器などに使用する p チャネルパワーMOSFET (耐圧-100、-200V の TO-254 タイプ及び SMD タイプ)に対する要求事項を規定するものである。この仕様書で規定される製品の概要は以下の通りである。

1.1 部品番号

部品番号は JAXA-QTS-2030 に準じて与えられ、次の例のように表す。



この仕様書で規定される製品の部品番号は、次のように与えられる。

JAXA R 2SJ1A01

JAXA R 2SJ1A02

JAXA R 2SJ1A03

JAXA R 2SJ1A04

JAXA R 2SJ1A05

JAXA R 2SJ1A06

JAXA R 2SJ1A07

JAXA R 2SJ1A08

JAXA R 2SJ1A09

JAXA R 2SJ1A10

JAXA R 2SJ1A11

1.2 絶対最大定格

この仕様書で規定される製品の絶対最大定格は以下の通りである。特に規定のない限り、 $T_{A}=+25^{\circ}\mathrm{C}$ とする。

部品番号	V _{DS} (V)	I _D (A)	I _{D(pulse)} (A)	V _{GS} (V)	T _C =2	P _D 25°C W)	P _D T _A =25°C (W)		T _{ch} (¹) (°C)	T _{stg} (°C)	R _{th(ch-c)} (°C/W)	R _{th(ch-a)} (°C/W)	安全 動作 領域
JAXA R 2SJ1A01	-100	-42	-168		250	図 5	2.60	図 6			0.5	48.0	図 7
JAXA R 2SJ1A02	-100	-25	-100		125	図 8	2.58	図 9			1.0	48.5	図 10
JAXA R 2SJ1A03	-100	-11	-44		62.5	図 11	2.55	図 12			2.0	49.0	図 13
JAXA R 2SJ1A04	-100	-42	-168		250	図 14					0.5		図 15
JAXA R 2SJ1A05	-100	-29	-116		150	図 16			450	-55 to 150	0.83		図 17
JAXA R 2SJ1A06	-100	-13	-52	. 20	70	図 18					1.67		図 19
JAXA R 2SJ1A07	-200	-35	-140	±20	250	図 20	2.60	図 21	150		0.5	48.0	図 22
JAXA R 2SJ1A08	-200	-16	-64		125	図 23	2.58	図 24			1.0	48.5	図 25
JAXA R 2SJ1A09	-200	-7.5	-30		62.5	図 26	2.55	図 27			2.0	49.0	図 28
JAXA R 2SJ1A10	-200	-37	-148		250	図 29					0.5		図 30
JAXA R 2SJ1A11	-200	-18	-72		150	図 31					0.83		図 32
JAXA R 2SJ1A12	-200	-8.5	-34		70	図 33					1.67		図 34

注(1) チャネル温度 Tch は次の式より与えられる。

 $T_{ch}=T_C + R_{th(ch-c)} \times P_D$

 $T_{ch}=T_A + R_{th(ch-a)} \times P_D$

ここで T_C: ケース表面温度 (°C)

T_A: 周囲温度(°C)

R_{th(ch-c)}: 接合部-ケース間熱抵抗 (°C/W)

R_{th(ch-a)}:接合部-周囲間熱抵抗 (°C/W)

P_D: 許容損失 (W)

1.3 主要電気的特性

この仕様書で規定される製品の主要電気的特性は以下の通りである。特に規定のない限り、 T_A=+25°C とする。

電気的特性(1/3)

	V _{(BR)DSS} (V)	I _{DSS} (µA)	I _{GSS} (nA)	V _{GS(th)} (V)	$R_{DS(on)}(^1)$ $(m\Omega)$	gfs(1) (S)	E _{AS} (mJ)
部品番号	I _D =-1mA V _{GS} =0V	V _{DS} =定格 V _{DS} の80% V _{GS} =0V	V _{GS} =±20V V _{DS} =0V	I _D =-1mA V _{DS} =V _{GS}	I _D =定格 I _D の 50% V _{GS} =-12V	I _D =定格 I _D の 50% V _{DS} =-25V	I _D =定格 V _{DD} =-48V, V _{GS} =-12V
	最小	最大	最大	最小-最大	最大	最小	最大
JAXA R 2SJ1A01	-100				45	8	1091
JAXA R 2SJ1A02	-100				97	8	458
JAXA R 2SJ1A03	-100				226 4		260
JAXA R 2SJ1A04	-100		100		38	8	1426
JAXA R 2SJ1A05	-100				90 8		598
JAXA R 2SJ1A06	-100	-10		-2.5~-4.5	219	4	391
JAXA R 2SJ1A07	-200	-10	±100	-2.5~-4.5	91	8	655
JAXA R 2SJ1A08	-200				210	8	358
JAXA R 2SJ1A09	-200				487	3.5	191
JAXA R 2SJ1A10	-200				84	8	809
JAXA R 2SJ1A11	-200				203	8	482
JAXA R 2SJ1A12	-200				480	3.5	299

注(¹) パルス試験: パルス幅≤1ms, デューティーサイクル≤2%

電気的特性(2/3)

BYM114 IT (= <)											
	Q _{GS} (nC)	Q _{GD} (nC)	Q _G (nC)	t _{d(on)} (ns)	t _r (ns)	t _{d(off)} (ns)	t _f (ns)				
部品番号	V _{DS} =定格 '	V _{DS} の50%,	I _D =定格 I _D ,	V _{DD} =定格 V _{DS} の 50%							
		V_{GS} =-12 V		I _D =定格 I _D , V _{GS} =-12V, R _G =10Ω							
	最大	最大	最大	最大	最大	最大	最大				
JAXA R 2SJ1A01	75	50	230	70	60	225	150				
JAXA R 2SJ1A02	30	20	95	50	25	115	45				
JAXA R 2SJ1A03	15	10	40	25	20	75	25				
JAXA R 2SJ1A04	75	50	230	70	60	225	150				
JAXA R 2SJ1A05	30	20	95	50	25	115	45				
JAXA R 2SJ1A06	15	10	40	25	20	75	25				
JAXA R 2SJ1A07	75	50	230	70	60	225	150				
JAXA R 2SJ1A08	30	20	95	50	25	115	45				
JAXA R 2SJ1A09	15	10	40	25	20	75	25				
JAXA R 2SJ1A10	75	50	230	70	60	225	150				
JAXA R 2SJ1A11	30	20	95	50	25	115	45				
JAXA R 2SJ1A12	15	10	40	25	20	75	25				

電気的特性(3/3) (寄生ダイオード特性)

		•					
	V _{SD} (¹) (V)	t _{rr} (ns)	Q _{rr} (µC)				
部品番号	I _F =定格 I _D V _{GS} =0V	I _F =定格 I _D , V _{GS} =0V, -di/dt=100A/µs, T _{ch} =25°C					
	最大	標準	標準				
JAXA R 2SJ1A01		260	2.0				
JAXA R 2SJ1A02		255	2.0				
JAXA R 2SJ1A03		215	1.5				
JAXA R 2SJ1A04		260	2.0				
JAXA R 2SJ1A05		255	2.0				
JAXA R 2SJ1A06	-2.0	215	1.5				
JAXA R 2SJ1A07	-2.0	375	4.5				
JAXA R 2SJ1A08		315	3.0				
JAXA R 2SJ1A09		280	2.5				
JAXA R 2SJ1A10		375	4.5				
JAXA R 2SJ1A11		315	3.0				
JAXA R 2SJ1A12		280	2.5				

<u>ニ(¹)</u> パルス試験: パルス幅≤1ms, デューティーサイクル≤2%

JAXA-QTS-2030/104A 令和 2 年 3 月 18 日制定

1.4 耐放射線性

この仕様書で規定される製品の耐放射線性は、次のとおりである。

保 証 記 号 耐放射線性保証水準 R 1000 Gy(Si){1×10⁵ rad(Si)} (ドーズレート 36Gy(Si)/ h~360Gy(Si)/ h)

2. 適用文書

契約又は適用時点で入手し得る次の文書の最新版は、この仕様書に規定されている範囲で、この仕様書の一部を成す。

JAXA-QTS-2030 宇宙開発用信頼性保証個別半導体デバイス共通仕様書

MIL-STD-750 Test Methods for Semiconductor Devices

(個別半導体デバイスの試験方法)

3. 要求事項

3.1 設計及び構造

製品の設計及び構造は、この項及び JAXA-QTS-2030 の 3.3 項に適合する。

3.1.1 ケース及び電極接続

ケース外形及び電極接続は、図 1a、1b、1c、1d に示す通りである。

3.1.2 電極材料及び仕上げ

a) TO-254 パッケージ

リード材料は、無酸素銅芯 Fe-Ni(Ni-Au メッキ)材を使用し、リード仕上げは JAXA-QTS-2030 の 3.3.7 c) 2) 2.3)項に規定する金めっき、又は 3.3.7 c) 2) 2.1)項に規定 する Pb-Sn はんだ浸せきに適合する。

b) SMD パッケージ

電極材料は Cu-W 合金とし、仕上げは金めっきである。

金めっきにおける金の純度は少なくとも 99.7%以上とし、厚さは 1.27 μ m 以上である。 下地はニッケルめっきで、厚さは 1.27 \sim 7.62 μ m である。

3.1.3 電気的特性

電気的特性は、表 1a 及び表 1b に示す通りである。

3.2 表示

製品の表示は、JAXA-QTS-2030 の 3.4 項によるほか、図 2a、2b、2c、2d に示す通りである。

3.2.1 検査ロット識別記号及び一連番号の表示

検査ロット識別記号及び一連番号の表示は、次に示す通りである。

例)

- a) 検査開始西暦年の末尾 2 桁の数字
- b) 1 検査ロット内の最初の検査サブロット(製造ロット)の封止週を表し、その年の1月第1 週から数えて封止した週2桁の数字
- c) 1 検査ロット毎に付随する 0 0 1 ~ 9 9 9 までの製品個々の連続番 3 桁の数字

3.3 認定

認定に関する要求事項は、JAXA-QTS-2030 の 3.1 項による。

4. 品質保証条項

4.1 一般的事項

一般的事項は、JAXA-QTS-2030 の 4.1 項の規定による。

4.2 受入材料の管理

受入材料の管理は、JAXA-QTS-2030 の 4.2 項の規定による。

4.3 製造工程の管理

製造工程の管理は、JAXA-QTS-2030 の 4.3 項の規定による。

4.4 工程内検査

工程内検査は、JAXA-QTS-2030 の 4.5 項の規定による。

4.5 スクリーニング

スクリーニングはJAXA-QTS-2030の4.7項の規定による。ここで測定すべき電気的特性、 試験条件及びデルタ限界値は以下に示す通りである。

4.5.1 測定すべき電気的特性

スクリーニングの中間点及び最終電気的特性試験においては、次に示されている電気的特性を測定する。

①中間点電気的特性試験

T_A=25°C

測定項目	V _{(BR)DSS} (V)	I _{DSS} (μΑ)			$R_{DS(on)}(^1)$ $(m\Omega)$	gfs(¹) (S)	V _{SD} (1) (V)	
MIL-STD-750 方法	3407	3413	3411	3404	3421	3475		
試験条件	バイアス条件 C I _D =-1mA V _{GS} =0V	バイアス条件 C V _{DS} = 定格 V _{DS} の 80% V _{GS} =0V	C I _D =-1mA		I _D =定格 I _D の 50% V _{GS} =-12V	I _D =定格 I _D の 50% V _{DS} =-25V	I _F =定格 I _D V _{GS} =0V	
	最小	最大	最大	最小-最大	最大	最小	最大	
JAXA R 2SJ1A01	-100				45	8		
JAXA R 2SJ1A02	-100				97	8		
JAXA R 2SJ1A03	-100				226	4		
JAXA R 2SJ1A04	-100				38	8		
JAXA R 2SJ1A05	-100				90	8		
JAXA R 2SJ1A06	-100	-10	±100	-2.5~-4.5	219	4		
JAXA R 2SJ1A07	-200	-10	±100	-2.5~-4.5	91	8	-2.0	
JAXA R 2SJ1A08	-200				210	8		
JAXA R 2SJ1A09	-200				487	3.5		
JAXA R 2SJ1A10	-200				84	8		
JAXA R 2SJ1A11	-200				203	8		
JAXA R 2SJ1A12	-200				480	3.5		

注(¹) パルス試験: パルス幅≤1ms, デューティーサイクル≤2%

②最終電気的特性試験:表 1a 及び表 1b のサブグループ 1, 2, 3 による。

4.5.2 試験条件

スクリーニングのゲートストレス試験、アバランシェ試験、温度サイクル、逆バイアスバーンイン試験及びバーンイン試験の試験条件は、次の通りである(ゲートストレス試験は工程内検査で実施)。

ゲートストレス試験 : V_{GS}=-35V, t=1ms, T_A =25°C

アバランシェ試験(E_{AS}) : I_{D(pulse)}=定格 I_D, V_{DD}=-48V, V_{GS}=-12V,

single pulse,

 $T_{C}=25^{\circ}C^{-5^{\circ}C}_{+10^{\circ}C}$ $\lambda 9-1$

 $L(mH) = \left[\frac{2E_{AS}}{(I_{D})^{2}}\right] \left[\frac{BV_{DSS} - V_{DD}}{BV_{DSS}}\right] \longrightarrow \vec{\Xi}(1)$

温度サイクル試験条件 : 条件 G, 20 サイクル

逆バイアスバーンイン試験条件(GS) : T_A = 150°C, V_{GS}=-16V

V_{DS}=0V, 48hr

バーンイン試験条件(DS) : T_A=150°C, V_{DS}=定格 V_{DS} の 80%

V_{GS}=0V, 240hr

4.5.3 デルタ限界値

バーンイン試験及び逆バイアスバーンイン試験におけるデルタ限界値は、次の通りである。

ΔI_{GSS}≤|20nA|

ΔI_{DSS}≤|10μA|

 $\Delta R_{DS(on)} \leq |20\%|$

 $\Delta V_{GS(th)} \leq |20\%|$

4.6 認定試験及び品質確認試験

認定試験及び品質確認試験は、JAXA-QTS-2030 の 4.6 項及び 4.8 項の規定による。また、ここで規定する外形寸法、電気的特性、試験条件及び許容値は図 1、図 3、表 1、表 2、表 3、表 4 及び表 5 よる。

ただし、品質確認試験のグルーブ C 試験及びグループ D 試験について、過去 1 年以内に認定試験又は品質確認試験のグルーブ C 試験及びグループ D 試験が実施され合格している場合はその試験を省略することがある。詳細は、表 6 による。

品質確認試験のグループ E 試験について、認定試験又は品質確認試験のグループ E 試験が実施され合格したウェーハロットのダイから製造された場合、チップサイズにかかわらず省略することがある。

4.6.1 静電気破壊試験条件

認定試験における静電気破壊試験は、次のピン組み合わせのもとで実施よる。 ゲート 対 ソース

4.6.2 耐放射線性試験条件

認定試験及び品質確認試験における耐放射線性試験(トータルドーズ)の試験水準、電気的特性、試験条件及び許容値は表 5 による。また照射中、照射後電気的特性の測定まで規定のバイアス印加を行い、照射後電気的特性の測定は、照射後 24 時間以内とする。

4.7 試験及び検査の変更

JAXA-QTS-2030 の付則 A、付則 B、付則 C に規定する試験及び検査からの変更はない。

4.8 長期間保管した製品の出荷

24 ヶ月以上保存した製品の出荷は、JAXA-QTS-2030 の 4.9.1 項の規定に従う。

5. 引渡の準備

引渡の準備は、JAXA-QTS-2030 の 5 項の規定による。

6. 注意事項

6.1 用語の定義

用語の定義は、JAXA-QTS-2030 の 1.2 項によるほか次による。

- (1) SEB(Single Event Burnout: シングルイベントバーンアウト)
 バイアス電圧を印加し、電流が流れないオフ状態において、陽子あるいは重粒子の入射によりデバイスが焼損する現象。
- (2) SEGR (Single Event Gate Rupture: シングルイベントゲートラプチャー) バイアス電圧を印加した状態において、陽子あるいは重粒子の入射により MOSFET の ゲート酸化膜が絶縁破壊する現象。

6.2 調達者に対する注意事項

調達者に対する注意事項は、JAXA-QTS-2030 の 6.2 項及び次による。

6.2.1 取り扱い上の注意事項

この仕様書によって規定された製品は酸化膜を持つ構造の為、静電気による破壊の可能性がある。そのため、運搬、作業環境などゲート・ソース間及びゲート・ドレイン間に静電気が印加されないように静電気対策を行うこと。

6.2.2 ベリリアについての注意事項

この仕様書に規定する製品は内部にベリリアを使用している。粉末、蒸気などの発生の恐れがあるような製品の分解及び化学的処理をしてはならない。廃棄する場合は関連法令に従うこと。

(2SJ1A01, 2SJ1A02, 2SJ1A03, 2SJ1A07, 2SJ1A08, 2SJ1A09 に使用)

表 1a グループ A 試験(¹)

				100	ıa ,	<i>) </i>		7 04	3/(/	1						
G <u>r.No</u>	MIL-STD-750	I			T 60: T	100V		I 66:	T 60:		I 66:		系列		T 60:	
Sub	試験項目	方法	JAXA R	2SJ 1A01	2SJ 1A02	2SJ 1A03	2SJ 1A04	2SJ 1A05	2SJ 1A06	2SJ 1A07	2SJ 1A08	2SJ 1A09	2SJ 1A10	2SJ 1A11	2SJ 1A12	
A -1	静特性試験	•						•			•	•				
	(T _A =25°C)		試験数量							PD 3						
-1a	ドレイン・ソース間降伏電圧	3407	条件						バイアス	条件 C						
	V_{DSS}							<u>ا</u> ا	_=-1mA	, V _{GS} =0	V					
			=			m							iin ' DO			
-1h	に 1にも 恵法	3411	許容値			-100	/ DC		ハ゛ イアス:	タルへ		-200V	/ DC			
-10	ゲート漏れ電流 I _{GSS}	3411	条件					V	/\ 1/\\: _{GS} =±20)\/					
	1000							v		ax	, v 					
			許容値	±100nA DC												
-1c	ドレイン遮断電流	3413	条件			バイアス	条件 C					バイアス	条件 C			
	I _{DSS}				V _{DS} =-80V, V _{GS} =0V V _{DS} =-160V, V _{GS} =0V											
										ax						
4.3	ビコロもいはます	2404	許容値	-10μA DC n* 17x条件 C												
-1d	ゲートしきい値電圧 V _{GS(th)}	3404	条件					١,			Δ					
	▼ GS(IN)							V	_{GS} =V _{DS}	, ıD≕- III	i.~					
			許容値					-2	2.5 ~ - 4	.5V D	С					
-1e	ドレイン・ソース間オン抵抗	3421	条件						ス試験(²)							
	R _{DS(on)}					I	 D					I	D			
				-21A	-12.5A	-5.5A	-21A	-14.5A	-6.5A	-17.5A	-8A	-3.75A	-18.5A	-9A	-4.25A	
						max	[mΩ]					max	[mΩ]			
4.			許容値	45	97	226	38	90	219	91	210	487	84	203	480	
-1f	順伝達コンダクタンス afs	3475	条件					ハ゛ル	ス試験(²)	, V _{DS} = -	·25V					
	gfs			24.4	-12.5A	-5.5A	1	l 4454	ا د د ۸	47.54	ا م		^{-18.5А}	0.4	1,054	
				-21A	-12.5A	-5.5A m	L	-14.5A	-6.5A	-17.5A	-8A	-L	-18.5A iin	-9A	-4.25A	
			許容値	8S	8S	4S	 8S	8S	4S	8S	88	3.58	8S	8S	3.5S	
-1g	ダイオード順電圧		条件					۸°,	ルス試験(2	²), V _{GS} =	:0V					
	V_{SD}					I	D	_					D			
				-42A	-25A	-11A	-42A	-29A	-13A	-35A	-16A	-7.5A	-37A	-18A	-8.5A	
			=							ax						
A -2	章在 永士 A4- □- → E4-	<u> </u>	許容値						-2.0V	DC						
A -2	静特性試験 (T _A =125°C)		試験数量						LTP	D 5						
-2a	<u>(: A= : 20 0)</u> ゲ−ト漏れ電流	3411	条件						ハ゛イアス:							
	I _{GSS}							V	GS=±20\		V					
	(125°C)									ax						
			許容値						±100n	A DC						
-2b	ドレイン遮断電流	3413	条件			ハ゛ イアス:		N /					条件C	W./		
	I _{DSS} (125°C)				V _I	os=-80\	/, V _{GS} =0	·V] ax	V	DS=-160	V, V _{GS} =0			
	(120 0)		許容値						m -25µA							
-2c	ケートしきい値電圧	3404	条件						ハ゛イアス:							
	$V_{GS(th)}$							V	_{GS} =V _{DS}		ıΑ					
	(125°C)						_	-		in						
	1917, 0 4001. 141.	2424	許容値	-2.0V DC パルス試験(²) , V _{GS} =-12V												
-2d	ドレイン・ソース間オン抵抗 R _{DS(on)}	3421	条件			ı		1 N.	人試験(²) 	, V _{GS} =-	12V					
	(125°C)			-21A	-12.5A	-5.5A		-14.5A	-6.5A	-17.5A	-8A	-3.75A	-18.5A	-9A	-4.25A	
	/				1 0, 1	max		1	1 0.0, (J	. D	[mΩ]	L	1	
			許容値	78	168	392	66	156	380	183	422	979	169	408	965	
											_					

注 (1) 同一の試料を全てのサブグループに対して用いることができる。

⁽²) パルス幅≤1ms, デューティーサイクル≤2%

表 1b グループ A 試験(¹)

								•	()						
Gr.No	MIL-STD-750					100√	系列					200V	系列		
Sub	試験項目	方法	JAXA R	2SJ 1A01	2SJ 1A02	2SJ 1A03	2SJ 1A04	2SJ 1A05	2SJ 1A06	2SJ 1A07	2SJ 1A08	2SJ 1A09	2SJ 1A10	2SJ 1A11	2SJ 1A12
		ЛД	JAXAK	TAUT	1A02	1A03	1A04	TAUS	TAUG	TAUT	1A06	1A09	IAIU	IAII	IAIZ
	(T _A =-55°C)		試験数量						LTF	PD 5					
-3a	ゲートしきい値電圧	3404	条件							条件 C					
	$V_{GS(th)}$							V	_{GS} =V _{DS}	, I _D =-1m	nΑ				
	(-55°C)								m	ax					
			許容値	ļ	-5.0V DC										
-3b	順伝達コンダクタンス	3475	条件	パルス試験(²), V _{DS} =-25V											
	gfs (FF°C)			044	1 40 5 4		D 044		l 0.54	47.54		 0 75 4) 40 = 4		1 4 05 4
	(-55°C)			-21A	-12.5A	L	-21A iin	-14.5A	-6.5A	-17.5A	-8A	-3.75A		-9A	-4.25A
			許容値	8.58	8.5S	4.5S		8.58	4.5S	8.58	8.5S	m 4.0S	8.5S	8.5S	4.08
A -4	動特性試験		n an	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
	(T _A =25°C)		試験数量						LTF	D 3					
	スイッチング	3472	条件			V _{DD} =	:-50V					V _{DD} =-	100V		
	(1) ターンオン時間				Vo		/, R _g =10	Ω			Vo	s=-12V		Ω	
	td(on)					l	D					. I ₁)		
	tr			-42A	-25A	-11A	-42A	-29A	-13A	-35A	-16A	-7.5A	-37A	-18A	-8.5A
	(2) ターンオフ時間		許容値		max						ſ	ma	ax	·····	T
	td(off)		td(on)	70	50	25	70	50	25	70	50	25	70	50	25
	tf		tr	60	25	20	60	25	20	60	25	20	60	25	20
			td(off)	225	115	75	225	115	75	225	115	75	225	115	75
			tf	150	45	25	150	45	25	150	45	25	150	45	25
1	安全動作領域		- 1 - 2 - 2 - 2												
	試験 (³)	3474	試験数量	i ———					LIF	D 5					
-6h	終止点電気的試験	3474	条件	i					C= A 4	 L 🗏 I°					
-05	水工川面火门四米								Gr.A-1	と同じ					
A -7	諸特性試験														
	(T _A =25°C) (⁴)		試験数量						LTP	D 10					
-7a	ゲートチャージ	3471	条件			V _{GS} =	:-12V					V _{GS} =	-12V		
	(1) ゲートチャージ: Qg					V _{DS} =	:-50V					V _{DS} =-	100V		
	(2) ゲートチャージ: Qgd					l	D					. I	D		
	(3) ゲートチャージ: Qgs			-42A	-25A	-11A	-42A	-29A	-13A	-35A	-16A	-7.5A	-37A	-18A	-8.5A
			許容値		T	T	ax		T			ma	T		T
			Qg	230nC	95nC	40nC	230nC	95nC	40nC	230nC	95nC	40nC	230nC	95nC	40nC
			Qgd	50nC	20nC	10nC	50nC	20nC	10nC	50nC	20nC	10nC	50nC	20nC	10nC
	-V = 4544	0.7=2	Qgs	75nC	30nC	15nC	75nC	30nC	15nC	75nC	30nC	15nC	75nC	30nC	15nC
-7b	逆回復特性	3473	条件	$I_F = I_D$ $I_F = I_D$							ا ـ ـ ـ ا				
	(1) T _{rr}			-42A	-25A	-11A	-42A	-29A	-13A	U	-16A	-7.5A	-37A	-18A	-8.5A
	(2) Q _{rr}									=0V I00A/µs					
			 許容値			m	 ax		- GI/GI-	Ισυνιμο		m	 ax		
			Trr	260	255	215	260	255	215	375	315	280	375	315	280
			Qrr	2.0	2.0	1.5	2.0	2.0	1.5	4.5	3.0	2.5	4.5	3.0	2.5

- 注 (1) 同一の試料を全てのサブグループに対して用いることができる。
 - (²) パルス幅≤1ms, デューティーサイクル≤2%
 - (3) A-1、A-2 及び A-3 の試験に供した試料を用いること。
 - (4) A-6の試験に供した試料を用いること。

表 2a グループB 試験

				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Gr.No	MIL-STD-750			100V 系列 200V 系列
	⇒ FA TA D	+:+	143/4 5	2SJ
Sub	試験項目	方法	JAXA R	
B -1	外形寸法検査(¹)		=+ F+ *+ =	水準 I (²) 3p
		2066	試験数量	水準Ⅱ(²) 3p
		2000	条件	図1による
B -2	耐溶剤性試験(³)(⁴)			水準 I 3p
			試験数量	水準Ⅱ 3p
		1022	条件	
				溶剤 a, b, 及び c
B -3b	熱衝撃試験		= > = > 14 =	水準 I 6p
	(気相)	1051	試験数量	水準Ⅱ 6p -55 ⁺⁰ -₅°C↔25 ⁺¹⁰ -₅°C↔150 ⁺⁵ -₀°C
		1051	条件	-55 [™] -5 [™]
				על לי 100 און
-3c	 サージ試験	4066	条件	
	(1) ゲートショック	4000	木口	V _{GS} =-35V
	(1) / 1/4//			•65- 00 •
	(2) アバランシェ	4066		V _{DS} =-48V, L=4.5.2 項の式(1)による。
			条件	I _{D(pulse)}
				-42A -25A -11A -42A -29A -13A -35A -16A -7.5A -37A -18A -8.5A
-3d	気密性試験	1071	条件	
	(1)微小			条件 H
	,			
				max
			許容値	1×10 ⁻³ Pa-cm ³ /s
	(2)グロス	1071	条件	
				条件 C
-3e	終止点電気的試験		条件	Gr.A-1 と同じ
-3f	内部目視及び	2075	条件	
	機械的検査	2071		
-3g	ポンド強度試験	2037	条件	条件 D
			許容値	ゲートワイヤ
				>90gf
				ソースワイヤ >300gf >300gf >90gf >300gf >300gf >90gf >300gf >90gf >300gf >90gf
-3h	SEM(1)	2077	条件	>300gi >300gi >90gi >300gi >300gi >90gi >300gi >300gi >90gi >300gi >300gi
"	52 ()	2011	木口	
-3i	ダイ剥離試験	l		水準 I 3p
			試験数量	水準Ⅱ 3p
		2017	条件	
				min
		<u> </u>	許容値	2.5kgf
B -4	はんだ付性試験(³) (⁴)			水準 I 6リード(⁵)
			試験数量	水準Ⅱ 6リード(⁵)
		2026	条件	

- 注 (1) 検査ロット編成前の試料で実施することができる。
 - (2) 水準 I は認定試験に、水準 II は品質確認試験に適用する (JAXA-QTS-2030 の C.3.2 及び C.3.3 項を参照)。
 - (3) 同一検査ロットの電気的不良品を使用することができる。
 - (4) 電気的不良品を使用する場合、試験に先立って良品がスクリーニング試験として受けるすべての熱的試験と同一の熱的条件に さらさなければならない。
 - (5) デバイス2個から各3リードを試験する。

表 2b グループB 試験

Gr.No	MIL-STD-750					100V	/系列					200V	/系列		
Sub	試験項目	方法	JAXA R	2SJ 1A01					2SJ 1A12						
	断続動作寿命試験				水準 I LTPD 10										
			試験数量						水準Ⅱ	12p					
		1042	条件					条件	D, 2000)サイク	'ル(1)				
- Fh	4 . L L = ← ¼ → 1 ★		AT IIL						0 1 1	1 - 18					
-30	終止点電気的試験		条件						Gr.A-1	と同し					
В -6с	定常ゲート		試験数量					가	〈準I	LTPD 1	0				
	ストレス試験								水準Ⅱ						
	(高温 GS 印加)	1042	条件					$V_{GS}=-2$	20V, T _A	=150°C	;, 48hr				
							また		_{GS} =-20\		75°C, 2	24hr			
-6d	終止点電気的試験		条件		Gr.A-1 と同じ										
-6e	加速定常	1042	条件		V _{DS} =-100V V _{DS} =-200V										
	逆パイアス試験		2111		V_{DS} =-100V V_{DS} =-200V T_{A} =150°C, 240hr										
	(高温 DS 印加)								t T _A =						
-6f	終止点電気的試験		条件						Gr.A-1	と同じ					
-6g	ボンド強度試験								20 ワ	イヤ					
			試験数量												
		2037	条件						条件	‡ D					
			許容値						ゲート	ワイヤ					
									>90						
				ソースワイヤ											
				300gf 300gf					>90gf						
B-7	熱インピーダンス試験			水準 I LTPD 10											
	$Z_{\text{th(ch-c)}}(\Delta V_{\text{SD}})$	0404	試験数量	·											
		3161	条件	T _A =25°C											
				max (°C/W) max (°C/W)											
			許容値	0.5	1.0	2.0	0.5	0.83	1.67	0.5	1.0	2.0	0.5	0.83	1.67

注 (¹) 引き続きグループ C 試験のサブグループ C1-1 の「断続動作寿命試験」の試料として使用する場合、6000 サイクルまで実施すること。

表 3 グループ C 試験

Gr.No	MIL-STD-750			100V 系列 200V 系列			
	3.2.30			2SJ			
Sub	試験項目	方法	JAXA R	1A01 1A02 1A03 1A04 1A05 1A06 1A07 1A08 1A09 1A10 1A11 1A12			
C 1-1a	断続動作寿命試験			水準 I LTPD 10			
			試験数量	水準Ⅱ LTPD 10			
		1042	条件	条件 D, 6000 サイクル(1)			
446	幼 .L 上手与めき除						
1-10	終止点電気的試験		条件	Gr.A-1 と同じ			
C 1-2a	定常パイアス印加			水準 I LTPD 5			
	寿命試験		試験数量	水準Ⅱ 適用しない			
	(高温 GS 印加) (²)	1042	条件	V _{GS} =-16V			
	()			T _A =150°C , 1000hr			
1-2b	終止点電気的試験		条件	Gr.A-1 と同じ			
	44 TT W. 45 V () DA45		Ж П	SILK I CIPJO			
				1.1%			
C 1-20	定常パイアス印加			水準 I LTPD 5			
	寿命試験		試験数量	水準Ⅱ 適用しない			
	(高温 DS 印加) (²) (³)	1042	条件	V_{DS} =-80V V_{DS} =-160V			
				T _A =150°C, 1000hr			
1-2d	終止点電気的試験		条件	Gr.A-1 と同じ			
				3 C [P] 0			
C -2a	熱衝撃試験			水準 I 12p			
	(温度サイクル)		試験数量	水準Ⅱ 12p 水準Ⅲ 適用しない			
		1051					
		1031	条件	-55 ⁺⁰ .₅°C↔25 ⁺¹⁰ .₅°C↔150 ⁺⁵ .₀°C			
				100 サイクル			
-2b	気密性試験	1071	条件	条件 H			
	(1)微小						
				max			
			許容値	1×10 ⁻³ Pa-cm ³ /s			
	(2)グロス	1071	条件	条件 C			
			7611	XII O			
-20	終止点電気的試験(4)		条件	Gr.A-1 と同じ			
-20	下二条 电太阳弧线 ()		木厂	OI.A-1 Z III C			
C 2	#an / 1.19 ±0	<u> </u>		196			
C-3	熱インピーダンス			水準 I LTPD 10			
	試験 (⁵) (⁶)		試験数量	水準 II 8p			
	$Z_{th(ch-c)}(\Delta V_{SD})$	3161	条件	T _A =25°C			
				max (°C/W) max (°C/W)			
			許容値	0.5 1.0 2.0 0.5 1.0 2.0 0.5 1.0 2.0 0.5 1.0 2.0			
C -4a	安全動作領域	<u> </u>		水準 I LTPD 10			
	以主动 F 		試験数量	水準Ⅱ LTPD 10			
	p~sX()	3474	条件	<u> 本 </u>			
46	幼.L 上五年 44-34 84 か			 Gr.A-1 と同じ			
-40	終止点電気的試験(7)		条件	GI.A-1 と同し			
C -6a	静電気破壊試験			水準 I 3p			
			試験数量	水準Ⅱ 適用しない			
		1020	条件	V _{GS}			
1				±2750V ±1000V ±500V ±2750V ±1000V ±500V ±2750V ±1000V ±500V ±2750V ±1000V ±500V			
				V _{DS} =0V			
-6b	終止点電気的試験		条件	V _{DS} =0V Gr.A-1 と同じ			
"	75-MICHAN		_ ^IT	Olin I E M C			
1	I	l	1				

注(1) 品質確認試験では、2000 サイクル最小とすることができる。

⁽²⁾ 捺印の判定は適用しない。

⁽³⁾ グループ C1-2a と別の試料で実施できる。

⁽⁴⁾ 気密性試験に先立って実施することができる。

⁽⁵⁾ 認定試験で熱インピーダンス曲線を求める。

⁽f) グループ B 試験で実施する場合は省略できる。

⁽⁷⁾ グループ A 試験で実施する場合は省略できる。

表 4a グループ D 試験

	Г			II
Gr.No	MIL-STD-750			100V 系列 200V 系列
	=+ EA = T			2SJ
Sub	試験項目	方法	JAXA R	1A01 1A02 1A03 1A04 1A05 1A06 1A07 1A08 1A09 1A10 1A11 1A12
D -1a	熱衝撃試験			水準 I LTPD 15
	(ガラス歪み)		試験数量	水準Ⅱ LTPD 15
		1056	条件	
				条件 B, 15 サイクル
-1b	熱衝擊試験	1051	条件	-55 ⁺⁰ .5°C↔25 ⁺¹⁰ .5°C↔150 ⁺⁵ .0°C
	(温度サイクル)			45 サイクル
-1c	リード強度試験	2036	条件	条件 A
				1.5kg, 30s
-1d	耐湿性試験	1021	条件	(MIL-STD-202、方法 106)
-1e	気密性試験	1071	条件	条件 H
	(1)微小			
				max
			許容値	1×10 ⁻³ Pa-cm ³ /s
	(2)グロス	1071	条件	
				条件 C
-1f	目視検査	1051	条件	
		1021		
1g	終止点電気的試験		条件	Gr.A-1 と同じ
D-2a	衝撃試験 (1)			水準 I LTPD 15
	,		試験数量	水準Ⅱ LTPD 15
		2016	条件	非動作, 14700 m/s² (1500G)
		20.0	*II	X ₁ ,Y ₁ ,Y ₂ 及び Z ₁ 方向 5 回
				N ₁ , 1 ₁ , 1 ₂ , 2, 3, 2 ₁ , 3, 1 ₃ , 3, 2 ₄
-2b	可変周波振動試験(1)	2056	条件	100 to 2000 Hz, 4min
			X11	196 m/s² (20G)
				X, Y, Z 4 🗎
-2c	定加速度試験(1)	2006	条件	98100 m/s ² (10000G)
	,			X ₁ ,Y ₁ ,Y ₂ 及び Z ₁ 方向
-2d	気密性試験(1)	1071	条件	条件H
	(1)微小			
				max
			許容値	1×10 ⁻³ Pa-cm ³ /s
	(2)グロス	1071	条件	
				条件 C
-2e	終止点電気的試験(1)		条件	Gr.A-1 と同じ
D-3a	塩気試験 (2)			水準 I LTPD 15
			試験数量	水準 II LTPD 15
		1041	条件	35°C, 24hr
				塩堆積率=10~50g/m²/24hr
1				

注 (1) サブグループ1に供試した試料を使用することができる。

 $^(^2)$ 同一検査ロットの電気的不良品を使用することができる。

表 4b グループ D 試験

Gr.No	MIL-STD-750				100V 系列 200V 系列										
Sub	試験項目	方法	JAXA R	2SJ 1A01	2SJ 1A02	2SJ 1A03	2SJ 1A04	2SJ 1A05	2SJ 1A06	2SJ 1A07	2SJ 1A08	2SJ 1A09	2SJ 1A10	2SJ 1A11	2SJ 1A12
D -5	内部水蒸気量検査(1)								水準Ⅰ	3p					
			試験数量						水準Ⅰ	[3p					
		1018	条件							-					
D -6a	はんだ耐熱性試験								水準 I						
			試験数量					水	隼Ⅱ 過	通用しな	い				
		2031	条件	0.5	-000 40			1000 10			50 % 4	•		1000 1	•
				250°C, 10s 240°C, 10s 250°C, 10s 240°C, 10s				0s							
-6b	目視検査		条件			•							•		
										· -					
-6c	気密性試験	1071	条件						条件	‡ H					
	(1)微小														
									ma	ax					
			許容値	1×10 ⁻³ Pa-cm ³ /s											
	(2)グロス	1071	条件												
				条件 C											
-6d	終止点電気的試験		条件						Gr.A-1	と同じ					

注 $(^1)$ 同一検査ロットの電気的不良品を使用することができる。

表 5 グループ E 試験

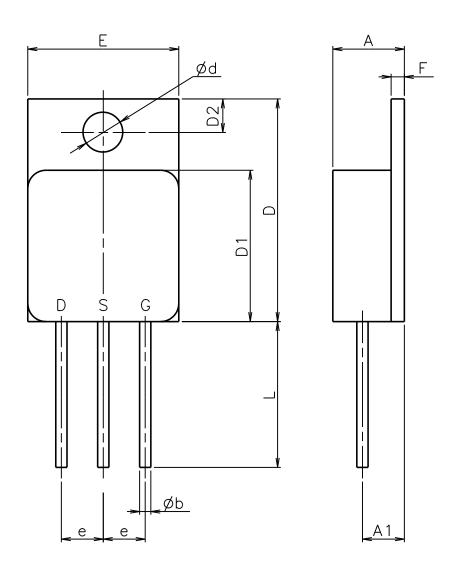
Gr.No	MIL-STD-750	1			100V系列 200V系列 200V系列				Г <u>оо</u> :	T 00:					
Sub	試験項目	方法	JAXA R	2SJ 1A01	2SJ 1A02	2SJ 1A03	2SJ 1A04	2SJ 1A05	2SJ 1A06	2SJ 1A07	2SJ 1A08	2SJ 1A09	2SJ 1A10	2SJ 1A11	2SJ 1A12
E -1a	耐放射線性試験				水準 I 4p(1)										
	(トータルドーズ試験)		試験数量		水準Ⅱ 4p(¹)										
		1019	条件						照射	·線量					
									1×10 ³	Gy(Si)					
									照射網	泉量率					
								36G)	/(Si)/h~	-360Gy	(Si)/h				
									ı,* /⊋·	2人14					
								(ハ 17 <i>7</i> 照射中.	ス条件 昭射後	(۵				
									את אז די, V _{DS} =0V						
						(b) V _{DS}	=-80V,		V DS-0 V			(b) V _{DS} =	=-160V.		
						V _{GS}						V _{GS} :			
-1b	終止点電気的試験							照	射後 24	 . 時間以	.内				
					WASTE TABLES TO SECOND										
(1)	ドレイン・ソース間降伏電圧	3407	条件						バイアス	条件 C					
	V_{DSS}							ا	=-1mA	, V _{GS} =0	V				
				min min											
			許容値			-100V	/ DC					-200V	DC		
(2)	ゲート漏れ電流	3411	条件						ハ゛ イアス:	条件 C					
	I _{GSS}							Vo	_{ss=±20} \	$V_{DS} = V_{DS}$	0V				
										ax					
		2442	許容値						±100n	A DC					
(3)	ドレイン遮断電流	3413	条件				条件 C					ハ゛ イアスミ			
	I _{DSS}				V	_{os} =-80V	, V _{GS} =	0V			V _{DS}	_S =-160\	/ , V _{GS} =	0V	
									m	ax					
			許容値						-10µA						
(4)	ゲートしきい値電圧	3404	条件						ハ゛ イアス:	条件 C					
	$V_{GS(th)}$			V_{GS} = V_{DS} , I_{D} =-1mA											
			許容値	-2.5 ~ - 4.5V DC											
(5)	ドレイン・ソース間オン抵抗	3421	条件	ก° มス試験(²) , V _{GS} =-12V											
	R _{DS(on)}			I _D I _D											
				-21A -12.5A -5.5A -21A -14.5A -6.5 A -17.5A -8A -3.75A -18.5A -9A -4.25A											
				max [$mΩ$] max [$mΩ$]											
			許容値	45	97	226	38	90	219	91	210	487	84	203	480

⁽²⁾ パルス幅≤ 1ms, デューティーサイクル≤2%

表 6 品質確認試験の省略

現検査ロットのスクリーニングの完了日から過去1年以内に、下表に該当する製品について該当試験が開始され、その試験に合格していた場合は、該当試験は省略することができる。

										SM	/ID-				
		パッケージ			TO-	254			2	1	0.5	2	1	0.5	
G	r.No		100V 系列		2	200V 系列		100V 系列		200V 系列		列			
	Sub	五型	2SJ	2SJ	2SJ	2SJ	2SJ	2SJ	2SJ	2SJ	2SJ	2SJ	2SJ	2SJ	
	Sub	<u> </u>	1A01	1A02	1A03	1A07	1A08	1A09	1A04	1A05	1A06	1A10	1A11	1A12	
		JAXA-QTS-2030 付則 C			チップ	サイズ					チップ	゚サイズ	ī		
	試験項目		1/1	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	1/1	1/2	1/4	
С	1-1a	断続動作寿命試験	次の 2	次の2つの条件を満たす場合、試験を省			次の2	2 つの条	件を満	たす場合	3、試験	を省略			
	1-1b	終止点電気的試験	略でき	る。					できる	5.					
	-2a	熱衝撃試験(温度サイクル)	同一	又はそ	れより:	大きい	チップサ	ナイズ	•同一	又はそ	れよりナ	トきいチ	ップサ	イズで	
ĺ	-2b	気密性試験	で試験	検を実施	色してい	る場合	0		試験	を実施し	している	場合。			
ĺ	-2c	終止点電気的試験	• 1. 2	項に規定	定するり	/DSと同	一又は	それよ	•1. 2 I	頁に規定	⊵する ν₀	s と同一	又はそ	れより	
			り大き	きいV _{DS}	で試験	を実施し	している	場合。	大きい V _{DS} で試験を実施している場合。						
	-3	熱抵抗試験	Gr.B-7	で実施	してい	る場合	、試験	を省略	できる。						
	-4a	安全動作領域試験	Cr A 6	で生物	ロテい	ス担ム	≕+∞	太少败 ·	できる。						
	-4b	終止点電気的試験	GI.A-C	ので美加		る場口	、 記入尚失	で 目略	C Z る。						
D	-1a	熱衝撃試験(ガラス歪み)													
	-1b	熱衝撃試験(温度サイクル)													
	-1c	リード強度試験													
	-1d	耐湿性試験							・パッ	ケージ	タイプ?	SMD-2 で	試験を	実施し	
	-1e	気密性試験							ている	る場合、	SMD-1 及	支び SMD	-0.5 (C.	よる試	
	-1f	目視検査							験を行	当略する	ことが	できる。			
	-1g	終止点電気的試験	任意 <i>0</i>) 1 製品	で実施	してい	る場合	試験	・パッ	ケージ	タイプ?	SMD-1 で	試験を	実施し	
ĺ	-2a	衝撃試験	を省略	できる	0				ている	る場合、	SMD-0.5	5 による	試験を	省略す	
ĺ	-2b	可変周波振動試験							ること	ヒができ	る。				
	-2c	定加速度試験													
	-2d	気密性試験													
İ	-2e	終止点電気的試験													
İ	-3a	塩気試験							任意(の 1 製品	で実施	している	る場合、	試験	
	-5	内部水蒸気量検査								各できる					

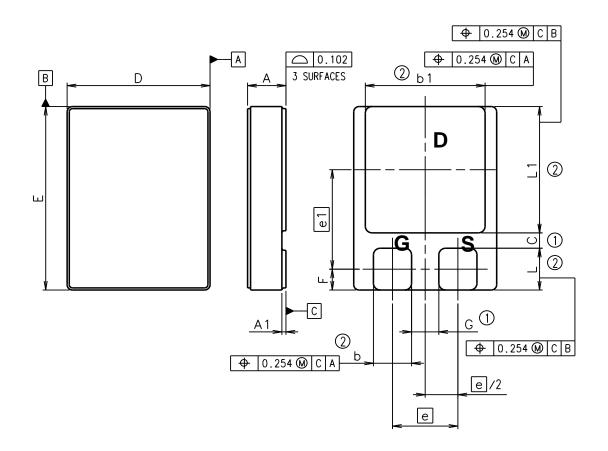


 記号	寸 法 (mm)						
865	最小値	最大値					
Α	6.35	6.65					
A 1	3.61	4.01					
ØЬ	0.90	1.14					
D	20.07	20.31					
D1	13.59	13.85					
D2	2.93	3.17					

記号	寸 法(mm)						
ly He	最小值	最大値					
Ød	3.56	3.80					
Ε	13.60	13.84					
е	3.51	4.11					
F	1.10	1.30					
L	12.84	13.60					

注意事項: すべてのリードはケースから絶縁されている。

図 1a TO-254 タイプのケース及びリード接続 (JAXA R 2SJ1A01, 2SJ1A02, 2SJ1A03, 2SJ1A07, 2SJ1A08, 2SJ1A09)



記号	寸 法 (mm)							
00.5	最小値	中心値	最大値					
Α			3.58					
A 1	0.254	0.381	0.508					
b	3.43	3.555	3.68					
b1	11.05	11.175	11.30					
С	0.89							
D	13.21	13.335	13.46					
Ε	17.40	17.525	17.65					

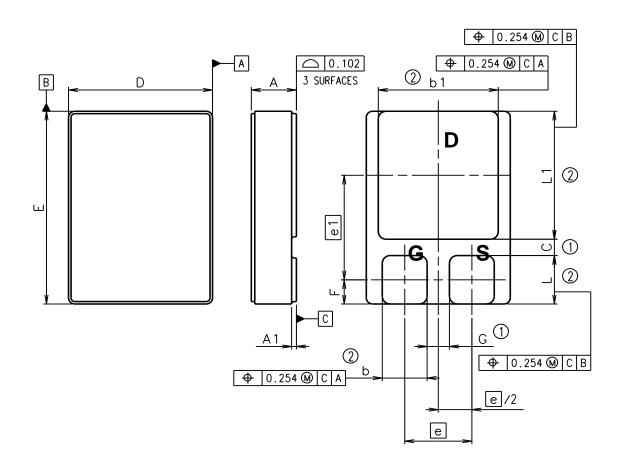
記号	寸 法 (mm)							
6.5	最小値	中心値	最大值					
e/2		3.05						
е		6.10						
e 1		9.50						
F		1.99						
G	1.27							
L	3.87	3.99	4.11					
L 1	11.94	12.065	12.19					

注: ① 寸法には、金属部のフラッシュ (ろう流れ等)も含める。

② 寸法には、金属部のフラッシュ (ろう流れ等) は含めない。

注意事項: すべての電極はケースから絶縁されている。

図 1b SMD-2 タイプのケース及び電極接続 (JAXA R 2SJ1A04, 2SJ1A10)



-								
記号	寸 法 (mm)							
8C 5	最小值	中心値	最大值					
Α			3.58					
A 1	0.254	0.381	0.508					
Ф	3.43	3.555	3.68					
b1	9.40	9.525	9.65					
С	0.76							
D	11.31	11.43	11.55					
E	15.75	15.875	16.00					

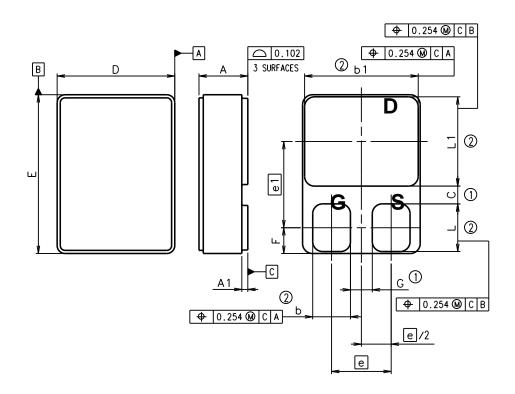
#D @	寸 法 (mm)							
記号	最小值	中心值	最大值					
e/2		2.67						
е		5.33						
e 1		8.61						
F		1.99						
G	0.89							
١	3.87	3.99	4.11					
L 1	10.42	10.54	10.66					

注: ① 寸法には、金属部のフラッシュ (ろう流れ等)も含める。

② 寸法には、金属部のフラッシュ (ろう流れ等) は含めない。

注意事項: すべての電極はケースから絶縁されている。

図 1c SMD-1 タイプのケース及び電極接続 (JAXA R 2SJ1A05, 2SJ1A11)



記号	寸 法 (mm)			
	最小值	中心値	最大値	
Α			3.12	
A 1	0.254	0.381	0.508	
b	2.29	2.415	2.54	
b1	7.14	7.265	7.39	
С	0.76			
D	7.40	7.52	7.64	
Е	10.04	10.16	10.28	

記号	寸 法 (mm)			
	最小值	中心値	最大値	
e/2		1.905		
е		3.81		
e 1		5.52		
F		1.65		
G	0.762			
L	2.93	3.05	3.17	
L 1	5.59	5.715	5.84	

注: ① 寸法には、金属部のフラッシュ (ろう流れ等)も含める。

② 寸法には、金属部のフラッシュ (ろう流れ等) は含めない。

注意事項: すべての電極はケースから絶縁されている。

図 1d SMD-0.5 タイプのケース及び電極接続 (JAXA R 2SJ1A06, 2SJ1A12)

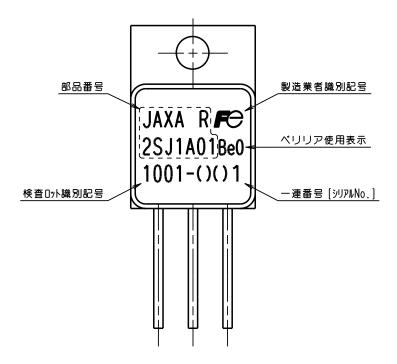


図 2a 表示内容(TO-254) (JAXA R 2SJ1A01, 2SJ1A02, 2SJ1A03, 2SJ1A07, 2SJ1A08, 2SJ1A09)

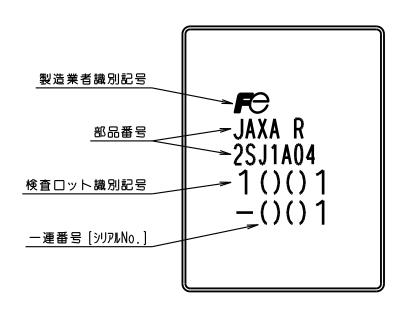


図 2b 表示内容 (SMD-2) (JAXA R 2SJ1A04, 2SJ1A10)

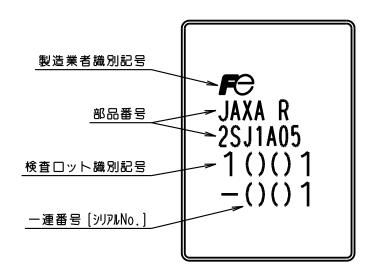


図 2c 表示内容 (SMD-1) (JAXA R 2SJ1A05, 2SJ1A11)

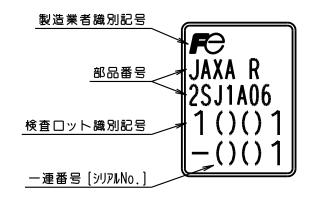


図 2d 表示内容 (SMD-0.5) (JAXA R 2SJ1A06, 2SJ1A12)

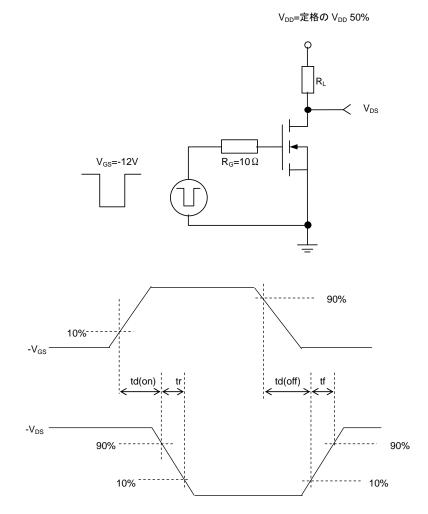


図3 スイッチング時間測定回路及び波形

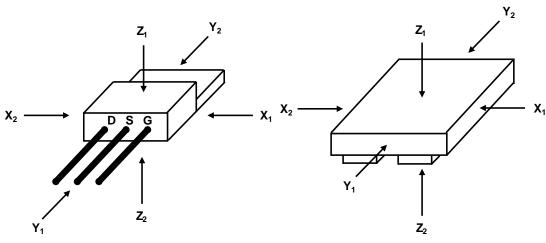


図4 デバイスの方位

JAXA R 2SJ1A01

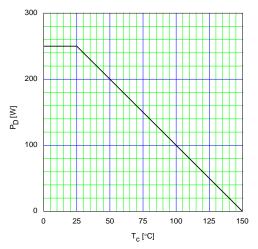


図5許容損失 PD- ケース表面温度 Tc

JAXA R 2SJ1A01

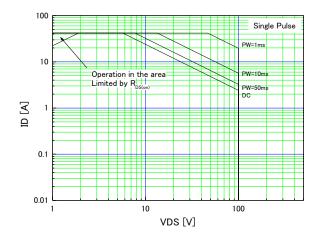


図7安全動作領域

JAXA R 2SJ1A02

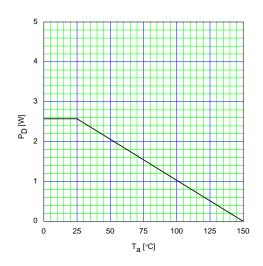


図 9 許容損失 PD - 周囲温度 Ta

JAXA R 2SJ1A01

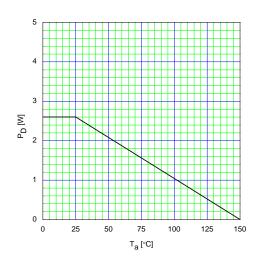


図6許容損失 PD - 周囲温度 Ta

JAXA R 2SJ1A02

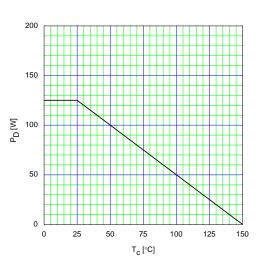


図8許容損失 P_D - ケース表面温度 T_c

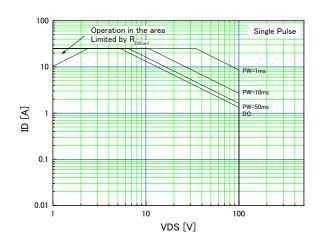


図 10 安全動作領域

JAXA R 2SJ1A03

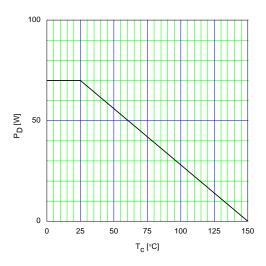
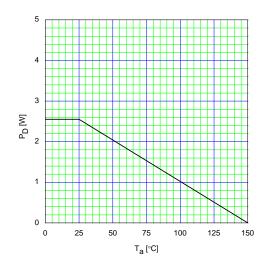


図 11 許容損失 P_D - ケース表面温度 T_c



JAXA R 2SJ1A03

図 12 許容損失 PD - 周囲温度 Ta

JAXA R 2SJ1A03

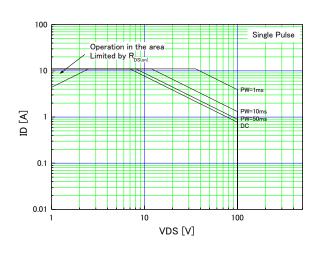


図 13 安全動作領域

JAXA R 2SJ1A04

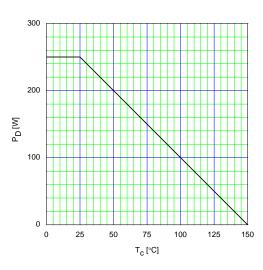


図 14 許容損失 P_D - ケース表面温度 T_c

JAXA R 2SJ1A04

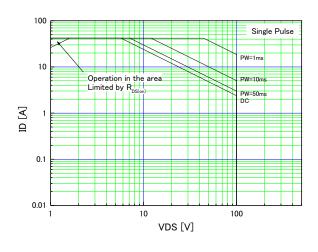


図 15 安全動作領域

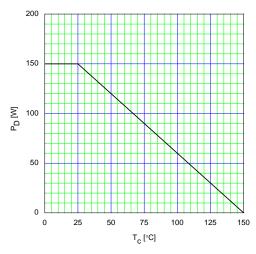


図 16 許容損失 P_D - ケース表面温度 T_c

JAXAR 2SJ1A05

100 Operation in the area Limited by R_{DS(on)} Single Pulse PW=1m Ξ 0.1 0.01 100 10 VDS [V]

図 17 安全動作領域

JAXAR 2SJ1A06

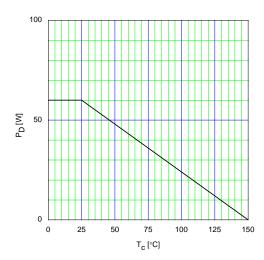


図 18 許容損失 PD - ケース表面温度 T。

JAXA R 2SJ1A06

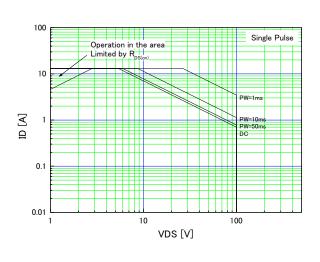


図 19 安全動作領域

JAXA R 2SJ1A07

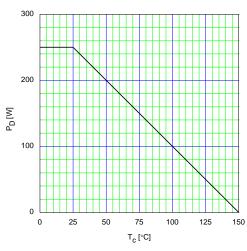
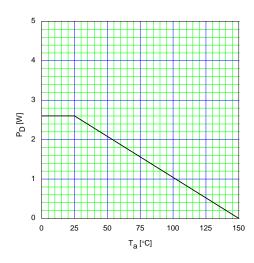


図 20 許容損失 P_D - ケース表面温度 T_c



JAXA R 2SJ1A07

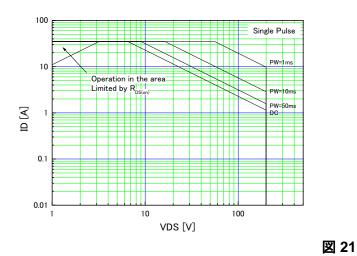


図 21 許容損失 PD - 周囲温度 Ta

図 22 安全動作領域

JAXA R 2SJ1A08

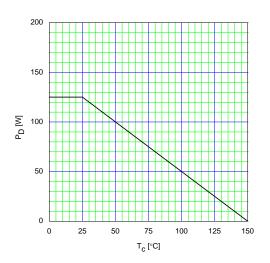


図 23 許容損失 PD- ケース表面温度 Tc

JAXA R 2SJ1A08

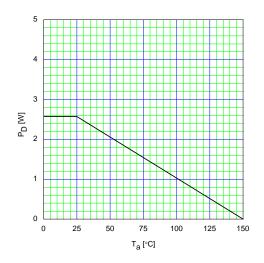


図 24 許容損失 PD - 周囲温度 Ta

JAXA R 2SJ1A08

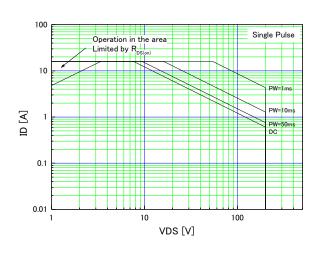


図 25 安全動作領域

JAXA R 2SJ1A09

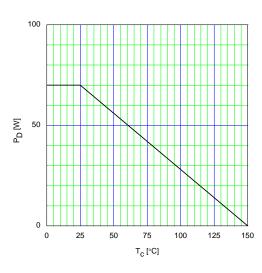


図 26 許容損失 P_D - ケース表面温度 T_c

JAXA R 2SJ1A09

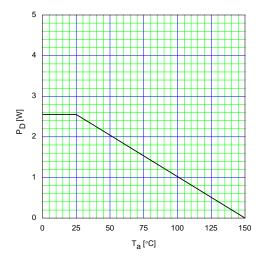


図 27 許容損失 PD - 周囲温度 Ta

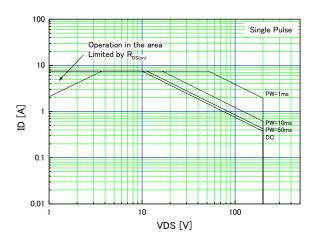


図 28 安全動作領域

JAXA R 2SJ1A10

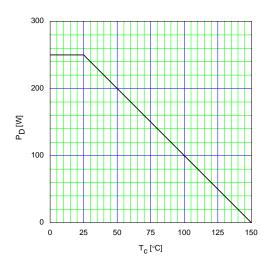


図 29 許容損失 PD- ケース表面温度 T。

JAXA R 2SJ1A10

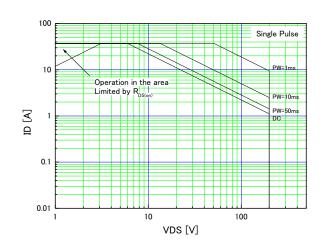


図 30 安全動作領域

JAXA R 2SJ1A11

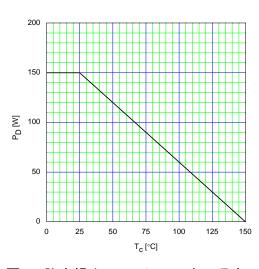


図 31 許容損失 PD- ケース表面温度 T。

JAXA R 2SJ1A11

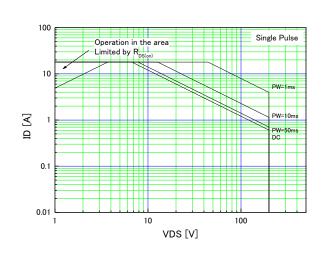


図 32 安全動作領域

JAXA R 2SJ1A12

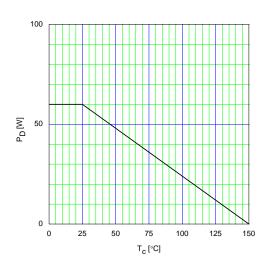


図 33 許容損失 PD- ケース表面温度 T。

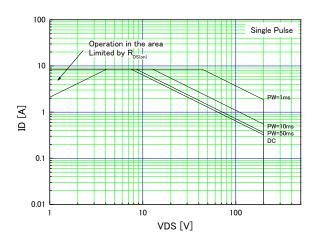


図 34 安全動作領域